

Pressemitteilung

KIOXIA beginnt mit der Auslieferung von Mustern der 9. Generation seines BiCS FLASH™ 1Tb TLC-Speichers

Die neuen Geräte kombinieren vorhandene Speicherzellen und fortschrittliche CMOS-Technologien für hohe Investitionseffizienz

Düsseldorf, 6. August 2026 – [KIOXIA Europe GmbH](#), ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, gab bekannt, dass die KIOXIA Corporation mit der Auslieferung von 1Tb (terabit) Triple-Level Cell (TLC)-Speichern begonnen hat, die mit der BiCS FLASH™ 3D Flashspeicher-Technologie der 9. Generation^[1] ausgestattet sind. Die Speicherlösungen wurden entwickelt, um Anwendungen wie etwa KI-fähige PCs und Smartphones zu unterstützen, die eine hohe Leistung und außergewöhnliche Energieeffizienz bei niedrigen bis mittleren Speicherkapazitäten erfordern.

KIOXIA verfolgt weiterhin eine Strategie mit zwei Achsen. Diese basiert auf der innovativen CBA-Technologie (CMOS directly Bonded to Array)^[2] und der OPS-Technologie (On-Pitch Select Gate Drain)^[3]. Im Rahmen ihrer einzigartigen zweiachsigen Strategie entwickelt KIOXIA gleichzeitig zwei unterschiedliche Produktlinien: Die Lösung der 9. Generation, die hohe Leistung zu relativ niedrigen Investitionskosten bieten, und die Lösung der 10. Generation, die fortschrittliches Layer-Stacking nutzt, um enorme Kapazitäten und überlegene Leistung zu erreichen.

Die neuen BiCS FLASH™ 1Tb TLC-Speicher der 9. Generation wurden unter Verwendung eines 230-Layer-Stacking-Verfahrens entwickelt und basieren auf der BiCS FLASH™ 3D Flashspeicher-Technologie der 8. Generation und fortschrittlicher CMOS-Technologie. Sie liefern eine NAND-

Schnittstellengeschwindigkeit von 4,8 Gb/s, eine Verbesserung von 33 % gegenüber Geräten der 8. Generation, und entsprechen der Leistung von Geräten der 10. Generation^[4].

Geleitet von seiner Mission „die Welt mit Speicher zu bereichern“ verpflichtet sich KIOXIA weiterhin der Förderung technologischer Innovationen, der Stärkung globaler Partnerschaften und der Bereitstellung fortschrittlicher Speicherlösungen für eine moderne KI-Infrastruktur.

###

Anmerkungen:

1: Diese Muster werden zum Zweck der Überprüfung der Funktionalität hergestellt; Die tatsächlichen Spezifikationen können sich bei der Serienproduktion unterscheiden.

2: Technologie, bei der jeder CMOS-Wafer und jeder Zellarray-Wafer separat in ihrem optimierten Zustand hergestellt und dann miteinander verbunden werden. Diese Technologie wird seit den BiCS FLASH™ Speicherlösungen der 8. Generation eingesetzt.

3: Eine Technologie, die es ermöglicht, die Bitleitung zu verkürzen und die Kapazität der Wortleitung zu verringern, indem nicht genutzte Speicherlöcher entfernt werden. Diese Technologie wird seit den BiCS FLASH™ Speicherlösungen der 8. Generation eingesetzt.

4: 1 Gbit/s wird als 1.000.000.000 Bits pro Sekunde berechnet. Dieser Wert wurde in einer spezifischen Testumgebung der KIOXIA Corporation erzielt. Die im tatsächlichen Gebrauch erreichten Ergebnisse hängen von den Bedingungen ab.

Die Produktdichte wird anhand der Dichte der Speicherchips im Produkt ermittelt, nicht anhand der Menge an Speicherkapazität, die dem Endbenutzer für die Datenspeicherung zur Verfügung steht. Die vom Verbraucher nutzbare Kapazität ist aufgrund von Overhead-Datenbereichen, Formatierung, fehlerhaften Blöcken und anderen Einschränkungen geringer und kann auch je nach Hostgerät und Anwendung variieren. Weitere Informationen finden Sie in den geltenden Produktspezifikationen. $1\text{Gb} = 2^{30}\text{ Bit} = 1.073.741.824\text{ Bit}$.

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sind die besten Werte, die in einer bestimmten Testumgebung bei der KIOXIA Corporation erzielt wurden. Die KIOXIA Corporation übernimmt jedoch keine Gewährleistung dafür, dass diese Lese- oder Schreibgeschwindigkeiten bei einzelnen Geräten erreicht werden. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten können abhängig vom benutzten Gerät variieren.

Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen können Marken von Drittunternehmen sein.

Über KIOXIA Europe GmbH



KIOXIA Europe GmbH ist die in Europa ansässige Tochtergesellschaft der KIOXIA Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von Flashspeicher- und Solid-State-Laufwerken (SSDs). Von der Erfindung des NAND-Flashspeichers bis hin zur Entwicklung der heutigen renommierten BiCS FLASH™ 3D-Flashspeicher ist KIOXIA Vorreiter auf dem Gebiet innovativer Speicherlösungen und -dienste, welche das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. Kioxias innovative 3D-Flashspeichertechnologie BiCS FLASH™ gestaltet die Zukunft der Speicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Datenzentren und generative KI-Systeme.

Besuchen Sie unsere [KIOXIA-Website](#)

Kontaktdaten für die Veröffentlichung:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-Mail: KIE-support@eu.kioxia.com

Kontaktdaten für redaktionelle Anfragen:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-Mail: lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Herausgegeben von:

Birgit Schöniger, Pretzl GmbH

Tel: +49 (0)172 617 8431

E-Mail: birgit.schoeniger@pretzl.com

Web: www.pretzl.com